1. Выбор схемотехнического решения.

Импульсные источники питания обладают такими приемуществами, как меньшие габариты и масса.

. Расчет подключения микросхемы КР1156ЕУ5.

. Схема защиты от короткого замыкания.

Защита от короткого замыкания обеспечена резисторами R5, R9 и входами Ipk микросхем DA1, DA2. Резисторы R5, R9 включены последовательно с нагрузкой и имеют сопротивление 0,1 Ом. При штатной работе схемы ток на каждом из них не превышает 1,1 А, что соответствует падению напряжения 0,11 В. При возникновении короткого замыкания ток и, следовательно, падение напряжения на них резко возрастет, и коэффициент заполнения сигнала на выходе Е микросхем снизится, уменьшая ток короткого замыкания.

. Схема защиты от перенапряжения.

Для защиты от перенапряжения использован TVS диод SA18A, имеющий минимальное напряжение открывания 20В, максимальную пиковую мощность 500Вт, максимальный импульсный ток 17 А. Данный элемент необходим для предотвращения повреждения схемы при подаче на вход напряжения, превышающего заданное (17В). При увеличении продолжительности импульса высокого напряжения на входе схемы ток, протекающий через TVS диод выведет из строя плавкий предохранитель FU1, рассчитанный на максимальный ток 4А и срабатывающий через 0,4…1,7 секунд. Таким образом, кратковременные импульсы высокого напряжения являются обратимыми для схемы, а продолжительные приводят к необходимости замены предохранителя.

. Схема защиты от переполюсовки.

Для предотвращения повреждения схемы от неправильной полярности подключения используется p-канальный МДП транзистор VT3 (FQP47P06). Затвор транзистора подключен к отрицательному входу источника питания, а сток – к положительному. Благодаря наличию в данном транзисторе диода между стоком и истоком, при подключении питания к схеме ток пойдет через диод от стока к истоку и создаст падение напряжения между затвором и истоком, которое откроет транзистор. После открытия транзистора основной ток будет течь через него, а не через диод. Согласно документации на транзистор FQP47P06, сопротивление канала не превышает 0,026 Ом, что при токе 2 А даст падение напряжения на транзисторе 0,026\*2 = 0,052 В, а рассеиваемая мощность составит 0,052\*2=0,104 Вт. Максимальное напряжение на затворе транзистора FQP47P06 составляет ±25В, что на 8 В больше напряжения питания схемы и на 5 В больше пробивного напряжения защитного TVS диода.